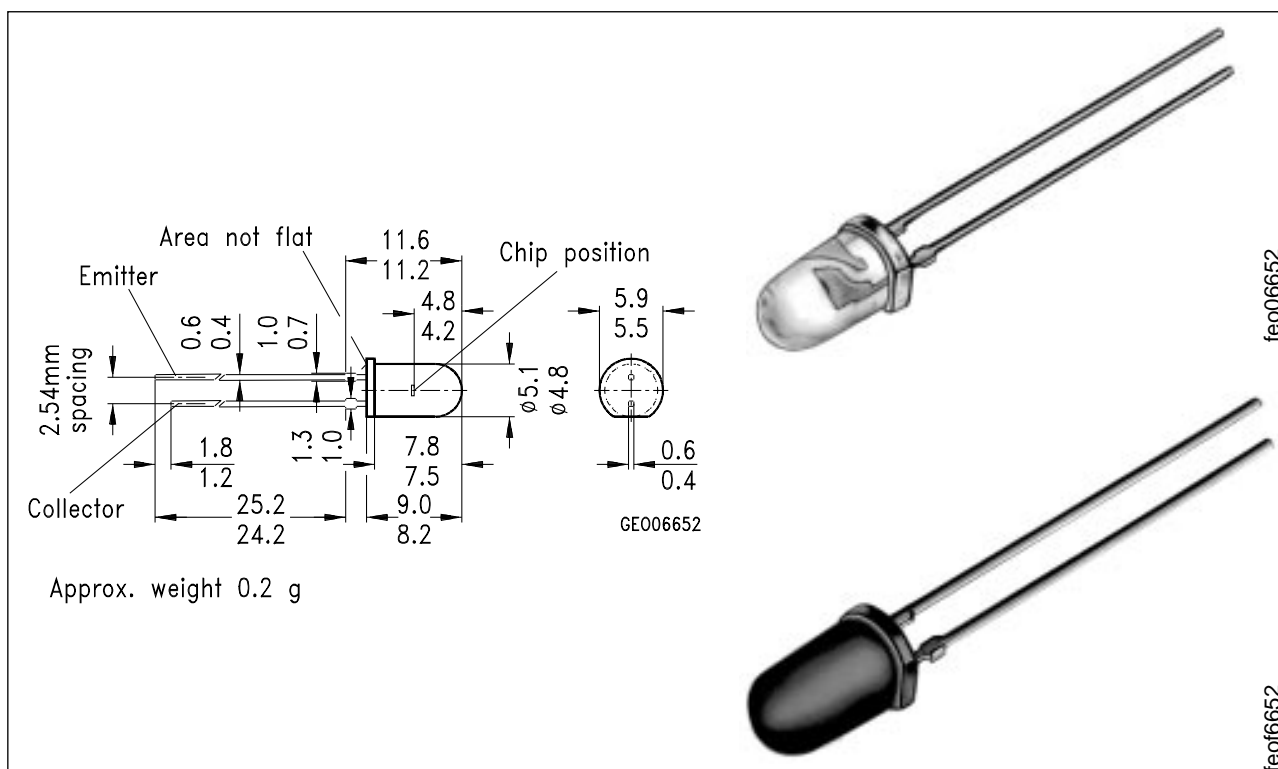


NPN-Silizium-Fototransistor Silicon NPN Phototransistor

SFH 300
SFH 300 FA



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 420 nm bis 1130 nm (SFH 300) und bei 880 nm (SFH 300 FA)
- Hohe Linearität
- 5 mm-Plastikbauform im LED-Gehäuse
- Gruppierbar

Anwendungen

- Computer-Blitzlichtgeräte
- Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- Industrieelektronik
- "Messen/Steuern/Regeln"

Features

- Especially suitable for applications from 420 nm to 1130 nm (SFH 300) and of 880 nm (SFH 300 FA)
- High linearity
- 5 mm LED plastic package
- Available in groups

Applications

- Computer-controlled flashes
- Photointerrupters
- Industrial electronics
- For control and drive circuits

Typ (*vorher) Type (*formerly)	Bestellnummer Ordering Code	Typ (*vorher) Type (*formerly)	Bestellnummer Ordering Code
SFH 300 (*BP 103 B)	Q62702-P1189	SFH 300 FA (*BP 103 BF)	Q62702-P1193
SFH 300-2 (*BP 103 B-2)	Q62702-P85-S2	SFH 300 FA-2 (*BP 103 BF-2)	Q62702-P1192
SFH 300-3 (*BP 103 B-3)	Q62702-P85-S3	SFH 300 FA-3 (*BP 103 BF-3)	Q62702-P1057
SFH 300-4 ¹⁾ (*BP 103 B-4)	Q62702-P85-S4	SFH 300 FA-4 (*BP 103 BF-4)	Q62702-P1058

¹⁾ Eine Lieferung in dieser Gruppe kann wegen Ausbeuteschwankungen nicht immer sichergestellt werden. Wir behalten uns in diesem Fall die Lieferung einer Ersatzgruppe vor.

¹⁾ Supplies out of this group cannot always be guaranteed due to unforeseeable spread of yield. In this case we will reserve us the right of delivering a substitute group.

Grenzwerte Maximum Ratings

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 55 ... + 100	°C
Löttemperatur bei Tauchlötung Lötstelle ≥ 2 mm vom Gehäuse, Lötzeit $t \leq 5$ s Dip soldering temperature ≥ 2 mm distance from case bottom, soldering time $t \leq 5$ s	T_s	260	°C
Löttemperatur bei Kolbenlötung Lötstelle ≥ 2 mm vom Gehäuse, Lötzeit $t \leq 3$ s Iron soldering temperature ≥ 2 mm distance from case bottom $t \leq 3$ s	T_s	300	°C
Kollektor-Emitterspannung Collector-emitter voltage	V_{CE}	35	V
Kollektorstrom Collector current	I_C	50	mA
Kollektorspitzenstrom, $\tau < 10 \mu s$ Collector surge current	I_{CS}	100	mA
Emitter-Kollektorspannung Emitter-collector voltage	V_{EC}	7	V

Grenzwerte Maximum Ratings (cont'd)

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Verlustleistung, $T_A = 25\text{ °C}$ Total power dissipation	P_{tot}	200	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance	R_{thJA}	375	K/W

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$, $\lambda = 950\text{ nm}$) Characteristics

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value		Einheit Unit
		SFH 300	SFH 300 FA	
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{S\text{ max}}$	850	870	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10\text{ \%}$ von S_{max} Spectral range of sensitivity $S = 10\text{ \%}$ of S_{max}	λ	420 ... 1130	730 ... 1120	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	A	0.12	0.12	mm ²
Abmessung der Chipfläche Dimensions of chip area	$L \times B$ $L \times W$	0.5×0.5	0.5×0.5	mm × mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseoberfläche Distance chip front to case surface	H	4.1 ... 4.7	4.1 ... 4.7	mm
Halbwinkel Half angle	φ	± 25	± 25	Grad deg.
Kapazität, $V_{\text{EC}} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$ Capacitance	C_{CE}	6.5	6.5	pF
Dunkelstrom Dark current $V_{\text{CE}} = 35\text{ V}$, $E = 0$	I_{CEO}	5 (≤ 100)	5 (≤ 100)	nA

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.

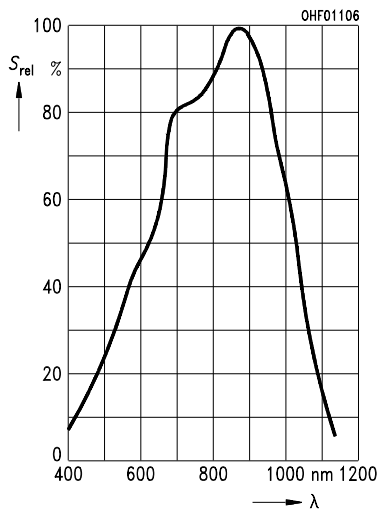
The phototransistors are grouped according to their spectral sensitivity and distinguished by arabian figures.

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value			Einheit Unit
		-2	-3	-4	
Fotostrom, $\lambda = 950 \text{ nm}$ Photocurrent $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$	I_{PCE}	0.63 ... 1.25	1 ... 2	≥ 1.6	mA
SFH 300: $E_v = 1000 \text{ lx}$, Normlicht/standard light A, $V_{CE} = 5 \text{ V}$	I_{PCE}	3.4	5.4	8.6	mA
Anstiegszeit/Abfallzeit Rise and fall time $I_C = 1 \text{ mA}$, $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$	t_r, t_f	7.5	10	10	μs
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage $I_C = I_{PCEmin}^{1)} \times 0.3$, $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$	V_{CEsat}	130	140	150	mV

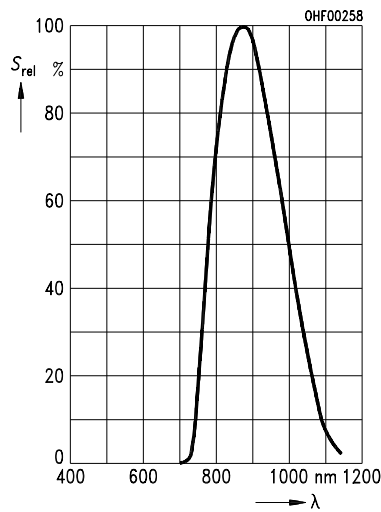
1) I_{PCEmin} ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe

1) I_{PCEmin} is the min. photocurrent of the specified group

**Relative spectral sensitivity,
SFH 300** $S_{rel} = f(\lambda)$

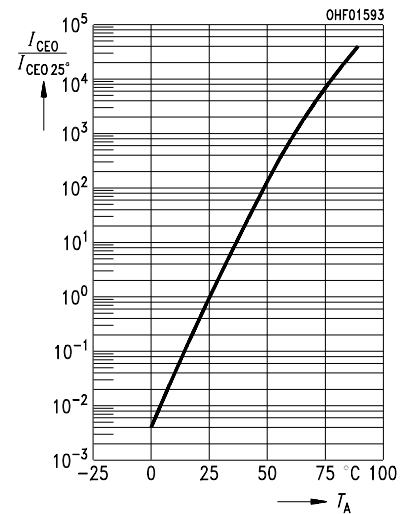


**Relative spectral sensitivity,
SFH 300 FA** $S_{rel} = f(\lambda)$



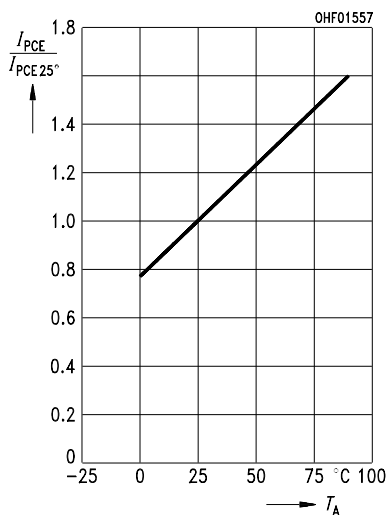
Dark current

$I_{CEO} / I_{CEO25^\circ} = f(T_A), V_{CE} = 25 \text{ V}, E = 0$



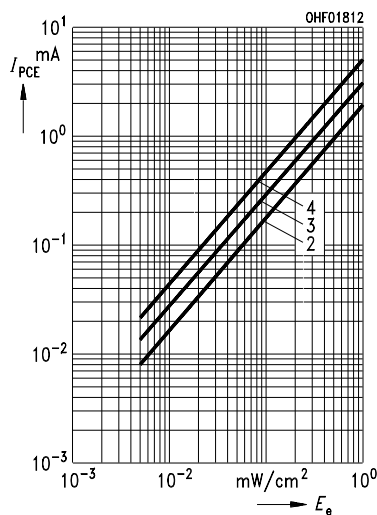
Photocurrent

$I_{PCE} / I_{PCE25^\circ} = f(T_A), V_{CE} = 5 \text{ V}$



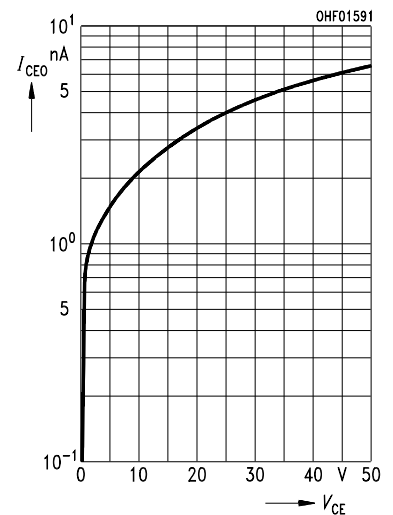
Photocurrent

$I_{PCE} = f(E_e), V_{CE} = 5 \text{ V}$

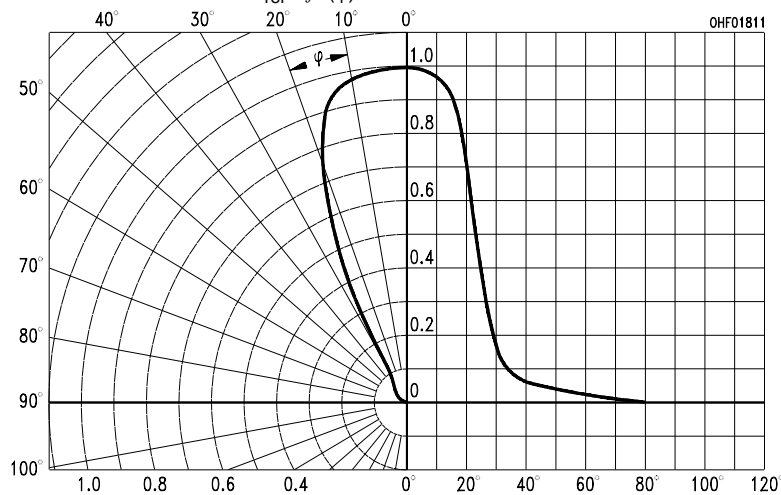


Dark current

$I_{CEO} = f(V_{CE}), E = 0$



Directional characteristics $S_{rel} = f(\varphi)$



Collector-emitter capacitance

$C_{CE} = f(V_{CE}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$

